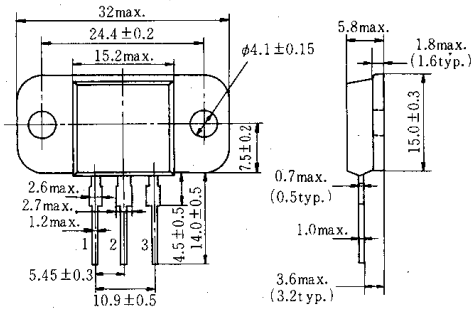


2SD829K

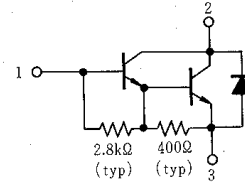
シリコン NPN 三重拡散形
大電流スイッチング用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
HIGH CURRENT SWITCHING



(HPAK)

1. ベース: Base
2. コレクタ: Collector
(フランジ)(Flang)
3. エミッタ: Emitter
(Dimensions in mm)

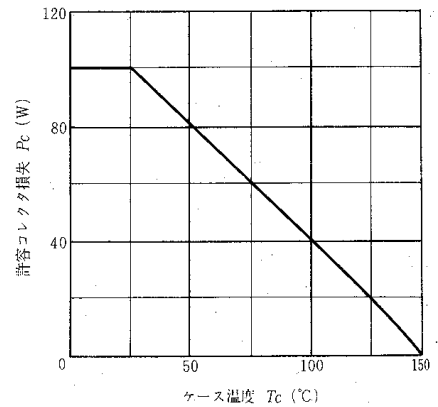


■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SD829K	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}		150	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}		120	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}		7	V
コレクタ電流	I_C		15	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$		20	A
許容コレクタ損失	P_C^*		100	W
接合部温度	T_j		150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}		-55~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値
* Value at $T_C=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CB0}$		$I_C=0.1\text{mA}, I_E=0$	150	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CE0}$		$I_C=50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	120	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$		$I_E=50\text{mA}, I_C=0$	7	—	—	V
直流電流増幅率	h_{FE}		$V_{CE}=2\text{V}, I_C=15\text{A}$ (pulse)	1000	4000	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$		$I_C=15\text{A}, I_B=25\text{mA}$	—	1.2	1.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(\text{sat})}$		$I_C=15\text{A}, I_B=25\text{mA}$	—	—	2.0	V
ターンオン時間	t_{on}		$I_C=10\text{A}, I_{B1}=-I_{B2}=25\text{mA}$	—	2	—	μs
ターンオフ時間	t_{off}		$I_C=10\text{A}, I_{B1}=-I_{B2}=25\text{mA}$	—	9	—	μs